

平成22年度 エV系(社会環境工学科) 第10回 電磁気学 I
天野 浩

項目

誘電体 コンデンサに蓄えられるエネルギー

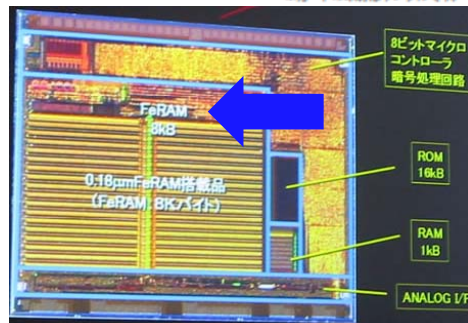
•本日は、コンデンサの静電容量を制御するための誘電体について学習します。

$$\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0 \quad \text{真空の誘電率 } \varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} [F / m]$$

様々な材料の比誘電率 ε_r

材料名	比誘電率
空気	1.000586
チタン酸バリウム	1200
水	80
石英ガラス	3.5~4.0
エポキシ樹脂	2.5~6
ポリエチレンテレフタレート(PET)	2.9~3
ナイロン	3.5~5.0

誘電体に関する最近のエレクトロニクスの話題



学生証などにもFeRAM

FeRAMは、構造などがDRAMに似ていて、フラッシュメモリの10倍以上に及ぶ高速な読み書きが可能である。また、信頼性の面においてもフラッシュメモリ、EEPROMに比べて格段に上とされている。

FeRAM: 強誘電体メモリ

<http://ascii.jp/elem/000/000/344/344538/>
<http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200510/05-055/>
<http://journal.mycom.co.jp/news/2003/07/09/11bl.jpg>
<http://www.usc-sbc.com/felica/index.htm>

低い誘電率材料もエレクトロニクスには重要

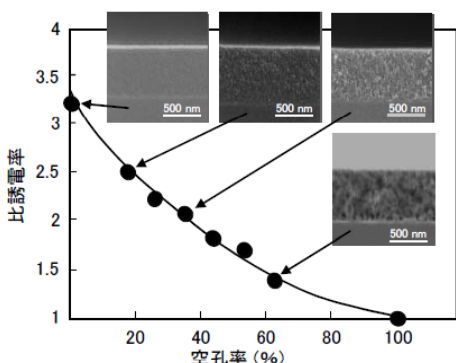
LSIの層間絶縁には低誘電率材料



* RC直列回路の時定数はCR
 → 高速化にはRとCを小さくする必要

* Cが大きい → 浮遊容量大きい → ノイズ、誤動作

MIRAIプロジェクトより



富士通ジャーナルより

<http://img.jp.fujitsu.com/downloads/jp/jmag/vol56-4/paper02.pdf>

誘電体の役割

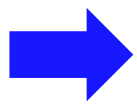
- * 絶縁
- * 電荷を溜める

誘電体を使うと、何がよいのか？

コンデンサ(キャパシタ)容量 $C = \varepsilon \frac{S}{d}$

ε : 誘電率 S: 面積 d: 電極間隔

$Q=C \cdot V$ なので、同じ電圧ならばCが大きい方がQが大きい。



誘電率の大きい材料を用いると、同じ面積、同じ電圧、同じ厚さで、蓄える電荷量を増やすことができる！

•空気＝絶縁体

- 電界があまりに大きくなると絶縁も壊れる。
- 空気の絶縁が壊れると...



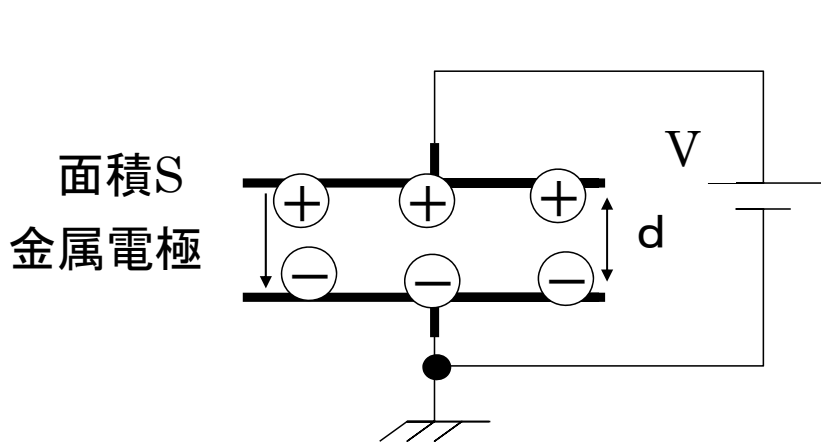
<http://www.aobaya.jp/photo1.html>

空気の絶縁破壊電界は
約30[KV/cm]
と言われている。

Q10-1 アルミニウム薄膜で表面をコーティングされた、空気中に浮かぶ半径50[m]の球形アドバルーンが帯電できる最大の電荷量[C]を求めよ。空気の絶縁破壊電界は 3×10^4 [V/cm]である。また、空気の誘電率 $\epsilon = 8.854 \times 10^{-12}$ [F/m]である。

空気以外の絶縁体(誘電体、不導体)

真空中の場合の平行平板コンデンサ



電極の全電荷

$$Q = C \cdot V = D \cdot S [C]$$

電界

$$\vec{E} = -\nabla \varphi [V/m]$$

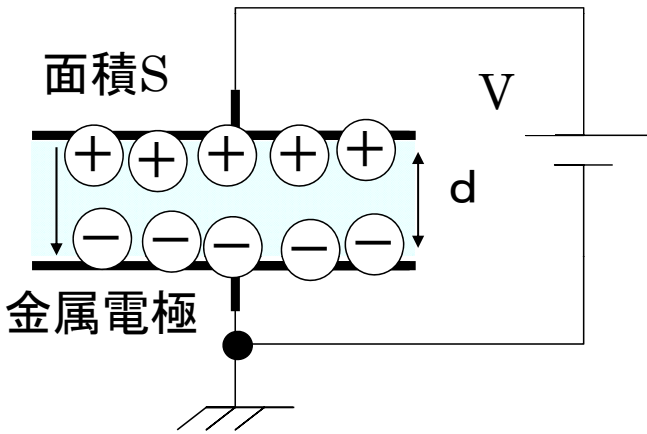
電束密度ベクトル

$$\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} [C/m^2]$$

$$E = \frac{V}{d}, C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$$

空気以外の絶縁体(誘電体、不導体)

電極間に誘電体を挟んだ時、誘電率が ϵ_0 から ϵ に変わったとする。



$\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ として、 ϵ_r を**比誘電率**と呼ぶ。
X線領域以外では、 $\epsilon_r > 1$

$$\epsilon_r = 1 + (\epsilon_r - 1)$$

$$\vec{D} = \epsilon \vec{E} = \epsilon_0 \epsilon_r \vec{E} = \epsilon_0 \{1 + (\epsilon_r - 1)\} \vec{E}$$

$$= \epsilon_0 \vec{E} + \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$$

$$= \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} [C/m^2]$$

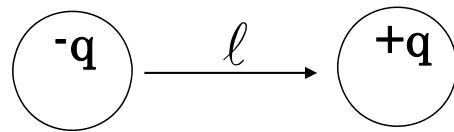
P を分極ベクトルと呼ぶ。単位 $[C/m^2]$

$$\vec{P} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E} [C/m^2]$$

空気以外の絶縁体(誘電体、不導体)

分極とは何か？

→ 物質内部で、電氣的に中性であったものが、電荷が発生する現象。



$$\vec{P} = \sum_i \vec{m}_i$$

$$\vec{m} = q \vec{l}$$

電気双極子

l は微小長さ、 m は電気双極子モーメント

物質内部に発生する電気双極子の総和が**分極** P

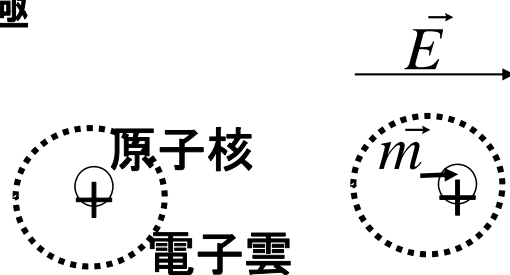
電気双極子に関しては第7回講義資料参照

Q10-2 真空中に点電荷 q [C]があるとき、距離 r [m]離れた点の電束密度 D [C/m²]を求めなさい。

$$\oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum q$$

分極の種類

1. 電子による分極



* 各原子の正電荷(原子核)と負電荷(電子)の重心位置のずれにより、電気双極子が発生する。

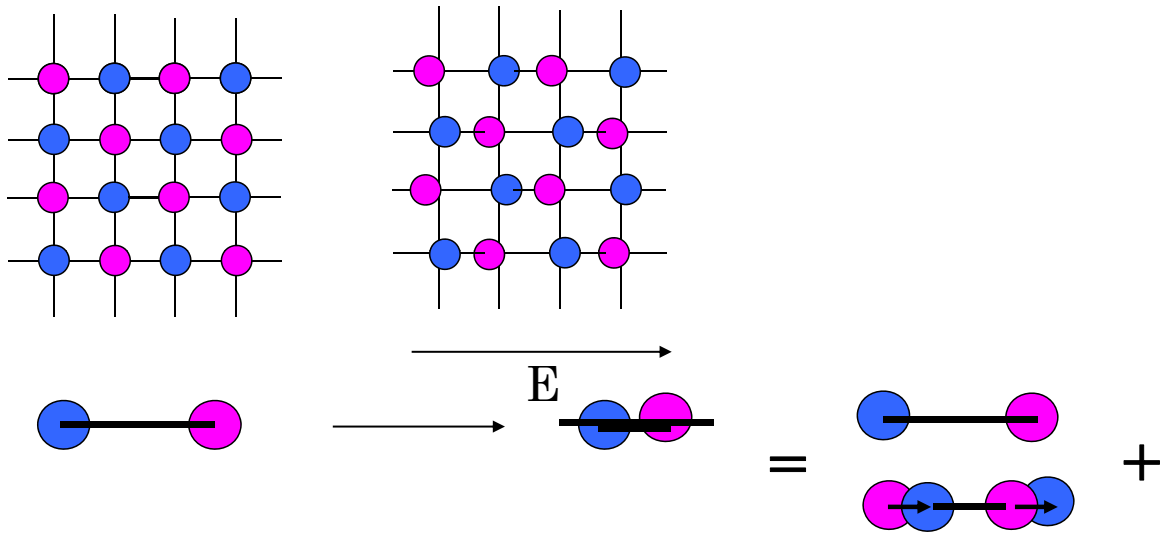
* 特徴: 電子は、原子核に強く束縛されているので、それほど大きくない。

* 電子は軽いので、早い周波数にも対応する。

分極の種類

2. イオン分極

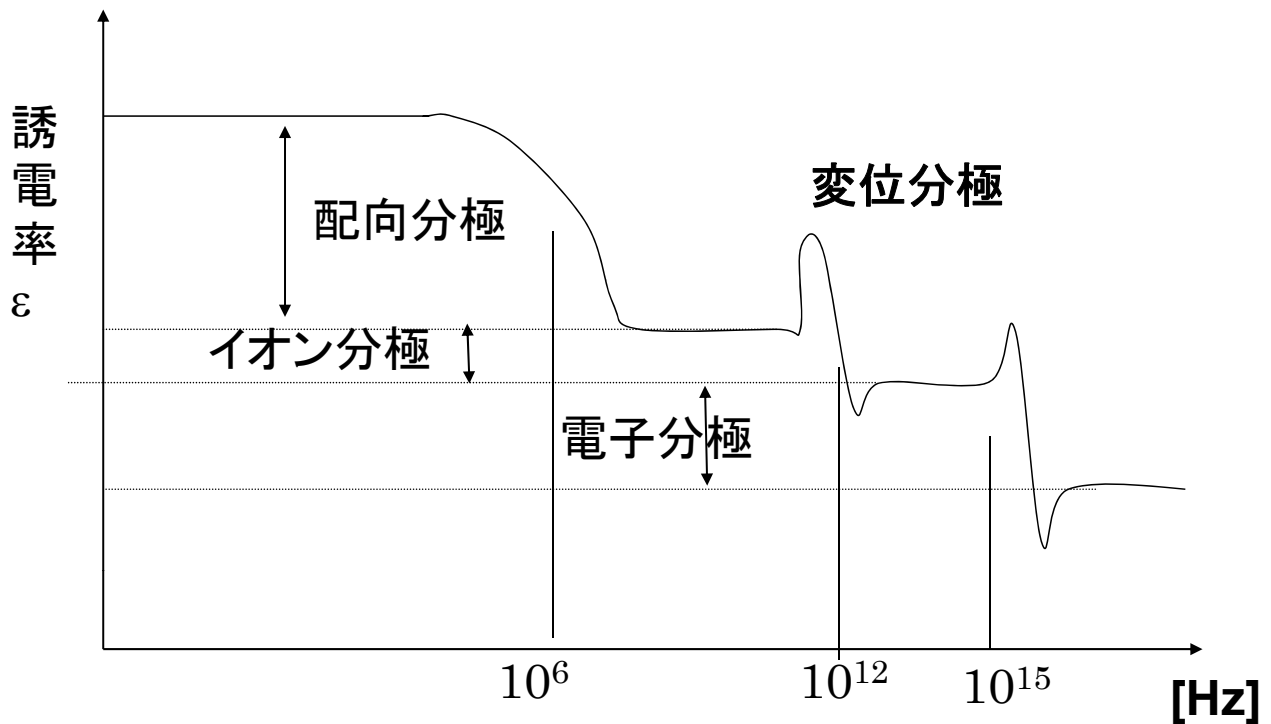
NaClのような結晶を考える。Na:正イオン(青) Cl:負イオン(赤紫)



元の格子+ずれた格子位置に電気双極子を配置することと同じ。
特徴: 格子振動に対応するので、赤外領域まで追従する。

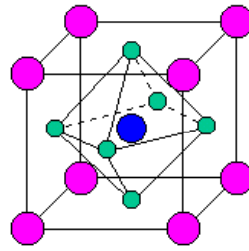
分極の種類

その他、極性ガスでの配向分極などがある。



一般的材料の誘電率の周波数依存性の概略

強誘電体材料の例



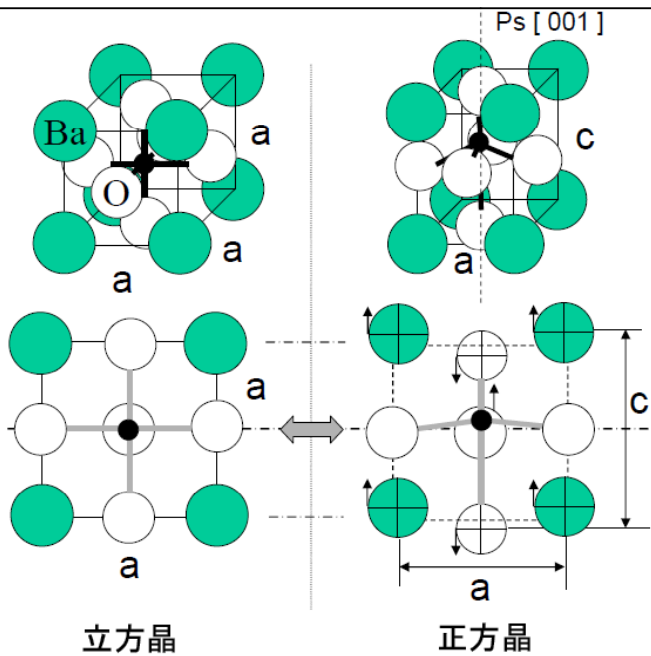
● : M
● : O
● : R

ペロブスカイト構造

例 $BaTiO_3$ (チタン酸バリウム)
 RMO_3

強誘電体・圧電体理解に関する図集
2007年1月版
楠本慶二著

<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ja/3/39/SCcrystal.png>



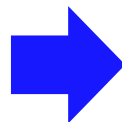
立方晶

正方晶

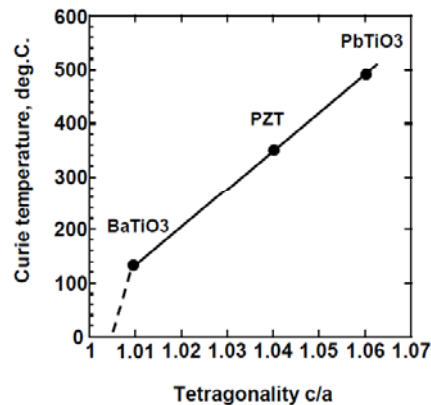
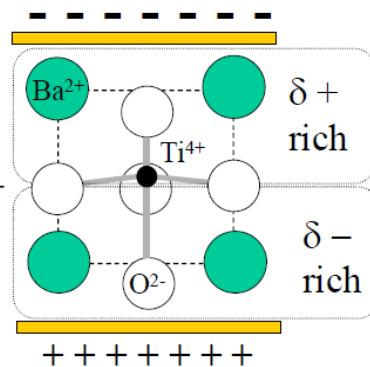
分極なし

分極あり

正方晶と立方晶の
相転移温度



Tiの位置がずれているために
自発分極が生じる



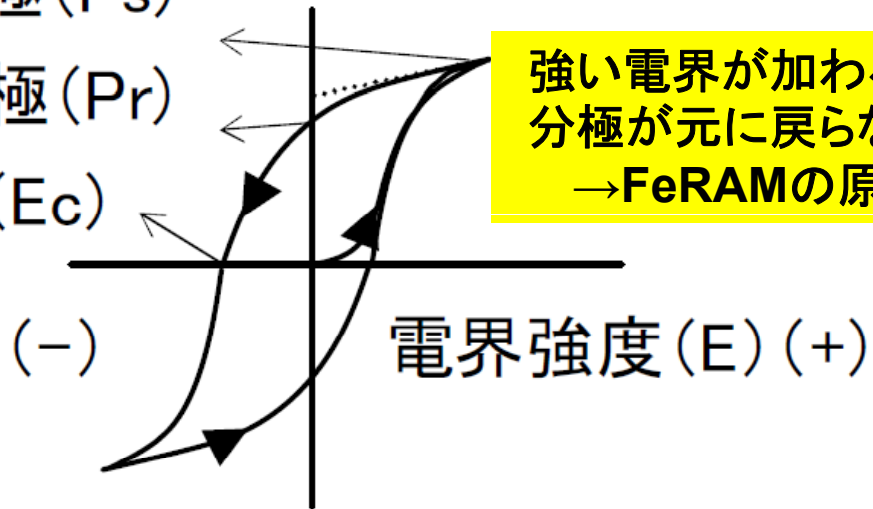
強誘電体材料の特徴

分極量(P)

自発分極 (P_s)

残留分極 (P_r)

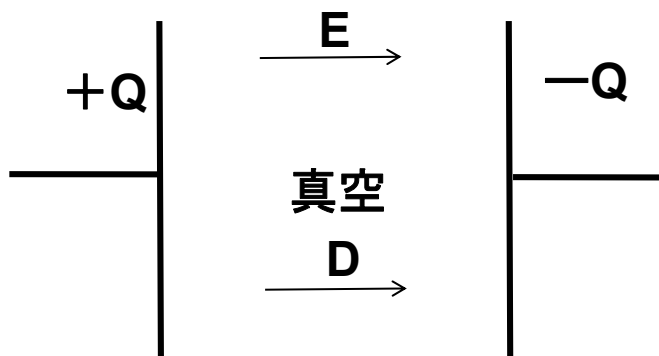
抗電界 (E_c)



強い電界が加わると、
分極が元に戻らない。
→ FeRAMの原理

典型的な強誘電体材料の分極量Pの電界強度E依存性

誘電体による電界ベクトルと電束密度ベクトルの変化



真空中の電界ベクトル

$$\vec{E}$$

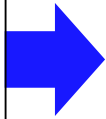
真空中の電束密度ベクトル

$$\vec{D}$$

誘電体中の電界ベクトル



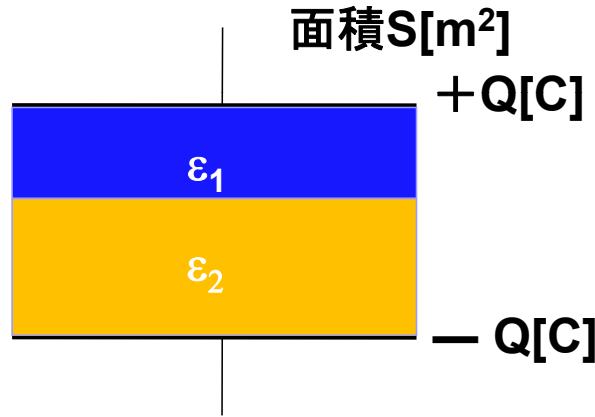
誘電体中の電束密度ベクトル



誘電体には、電界を弱める作用がある。

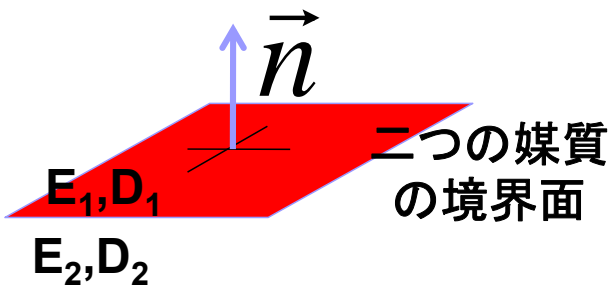
前回の復習

異なる誘電体材料が接している場合は、どのように考えればよいか？



コンデンサの断面図

異なる誘電体が接している場合の電界の考え方



電界を周回積分したらゼロのはず $\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$

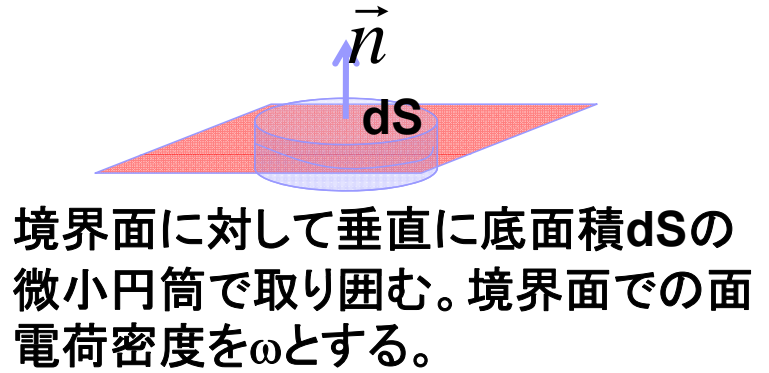
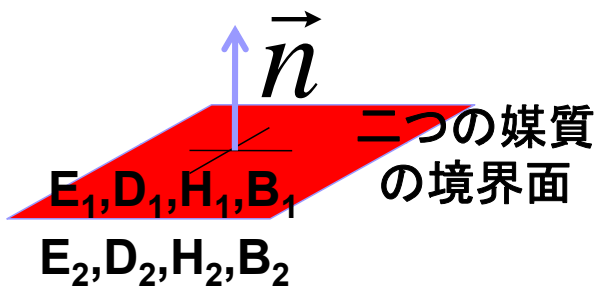
ABCDは極めて薄いので、ABの積分およびCDの積分は無視する。
単位接線ベクトルをtとする。

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = BC \cdot \vec{t} \cdot \vec{E}_2 - DA \cdot \vec{t} \cdot \vec{E}_1 = 0$$

BC=DAなので $\vec{E}_1 \cdot \vec{t} = \vec{E}_2 \cdot \vec{t}$

すなわち、二つの誘電体の界面における電界 E_1, E_2 の接線成分は等しい。

異なる絶縁体が接している場合の電束密度の考え方



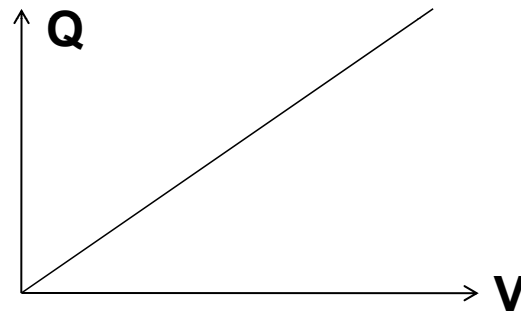
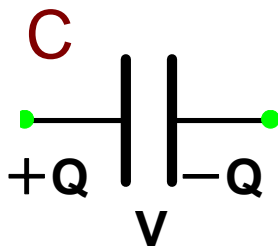
ガウスの法則より

$$\begin{aligned} \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= \vec{D}_1 \cdot \vec{n} dS - \vec{D}_2 \cdot \vec{n} dS \\ &= \omega \cdot dS \\ \therefore (\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \vec{n} &= -\omega \end{aligned}$$

境界面に電荷がない場合 $(\vec{D}_2 - \vec{D}_1) \cdot \vec{n} = 0$

誘電体境界面上における電束密度 D_2, D_1 の法線成分は等しい。

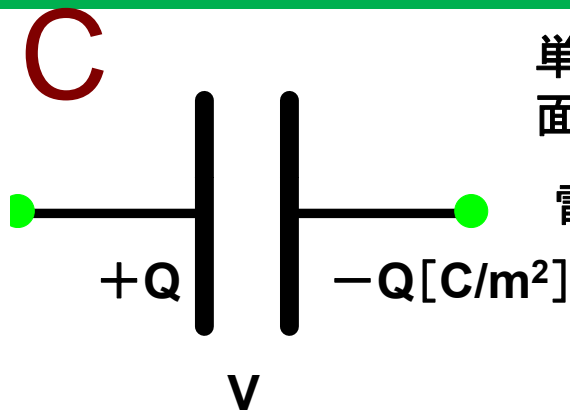
コンデンサに蓄えられるエネルギー



- 平行平板コンデンサの場合、コンデンサに溜まる電荷 Q と平板間の電圧 V は、コンデンサの静電容量を C とすると $Q=CV$
- 電圧がゼロの状態から V まで充電したとすると、 dV だけ電圧が変化したとき $Q \times dV$ だけエネルギーが増えるので、エネルギーの増加分は

$$\int_0^V Q \cdot dV = C \int_0^V V \cdot dV = \frac{1}{2} CV^2 [J] \leftarrow \text{静電エネルギー}$$

同じことを電界で考える場合



単位面積当たりの電荷 $+Q$ 、 $-Q$ [C/m²]、面積 S [m²]、電極間距離 d [m] とする。

電極間の電界 E [V/m] は、

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad \rightarrow \quad V = E \cdot d$$

静電容量 C [F] は、 $C = \epsilon_0 \frac{S}{d}$

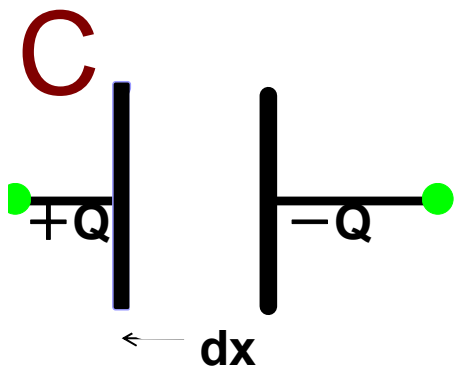
従って、静電エネルギーは

$$\frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 \frac{S}{d} (E \cdot d)^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 \times Sd$$

単位体積当たりの静電エネルギーとすると $\frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$ [J / m³]

平行平板間に働く力

電荷 Q が一定のとき



静電エネルギーは $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$ [J]

もともと平板間には、引力が働いておりその力を F とする。

* F に逆らって片方の平板を dx だけ動かすと、 $F \cdot dx$ だけ仕事をしたことになる。

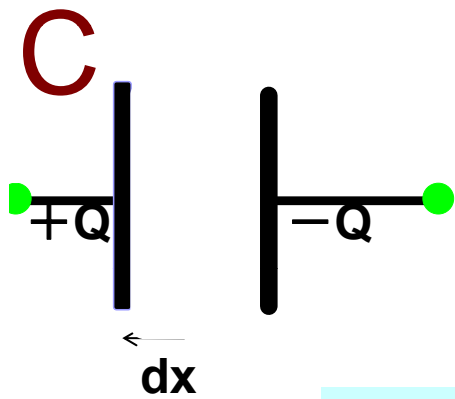
* 静電エネルギーは dW だけ変化する。

* 外部からのエネルギー供給がないので、変化分の総和はゼロ

$$F \cdot dx + dW = 0 \Rightarrow F = -\frac{dW}{dx}$$
 [N] **引力**

平行平板間に働く力

電圧Vが一定のとき



$$\text{静電エネルギー } W = \frac{1}{2} CV^2 [J]$$

•電圧Vを維持するために電荷Qが変化する。→電源から電荷が供給される。

$$F \cdot dx + dW = V \cdot dQ$$

$$dW = \frac{1}{2} dC \cdot V^2$$

$$V \cdot dQ = dC \cdot V^2$$

$$\therefore F \cdot dx = dC \cdot V^2 - \frac{1}{2} dC \cdot V^2 = dW \Rightarrow F = \frac{dW}{dx} [N]$$

斥力

コンデンサに蓄えられる静電エネルギーのまとめ

面積 $S [m^2]$
 $+Q [C]$

静電エネルギー W は $W = \frac{Q^2}{2C} = \frac{C}{2} V^2 [J]$

誘電体にかかる力 F は、

$$F = -\frac{dW}{dx} [N]$$

電荷 Q が一定 (引力)

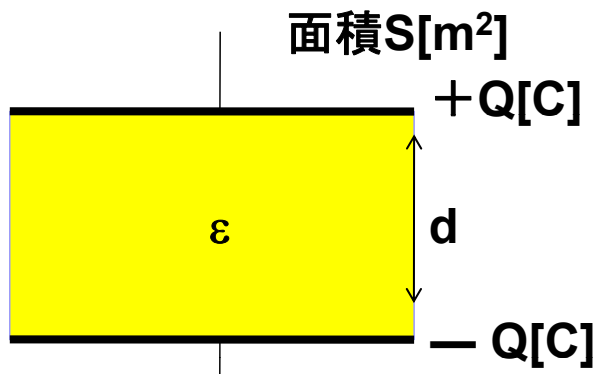
$$F = \frac{dW}{dx} [N]$$

電圧 V が一定 (斥力)

電位差 $V [V]$

$-Q [C]$

コンデンサに蓄えられる静電エネルギーと誘電体



電界ベクトルと電束密度ベクトル
 で書きなおすと

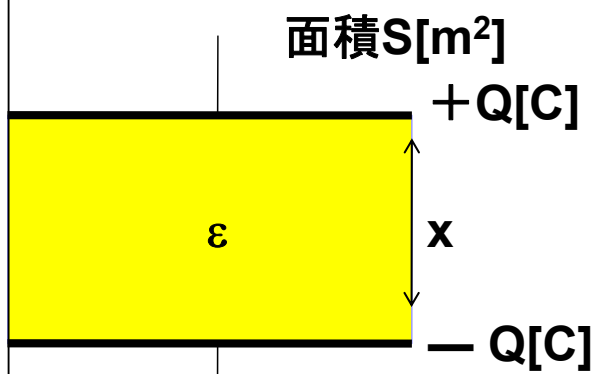
W を書きなおすと

電位差 $V[V]$

$$W = \frac{C}{2} V^2 = \frac{QV}{2} = \frac{(D \cdot S)(E \cdot d)}{2} = \frac{ED}{2} Sd [J]$$

$$\therefore w = \frac{ED}{2} [J/m^3]$$

誘電体表面に働く力



電位差 $V[V]$

誘電体には力が加わる！

電荷 Q が一定

電圧 V が一定

$$W = \frac{ED}{2} Sx [J]$$

(電極を離す方向を+)

電荷 Q が一定(引力) $F = -\frac{dW}{dx} = -\frac{ED}{2} S [N]$

電圧 V が一定(斥力) $F = \frac{dW}{dx} = \frac{ED}{2} S [N]$

Q10-3 極板面積 $S[\text{m}^2]$ 、極板間隔 $d[\text{m}]$ の平行板コンデンサの極板間を誘電率 ε の誘電体で満たし、それぞれの極板に $+\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ 、 $-\sigma[\text{C}/\text{m}^2]$ の面積密度の電荷を与えた。この平行板コンデンサの静電容量 C を下記の静電エネルギーの関係式から求めなさい。

$$W = \frac{D \cdot E}{2} (S \cdot d) = \frac{Q^2}{2C} [J]$$

Q10-4 内球の半径が $a[\text{m}]$ 、外球の半径が $b[\text{m}]$ の同心球導体がある。内球に $+Q[\text{C}]$ 、外球に $-Q[\text{C}]$ の電荷を与えたとき、内外球間に蓄えられる静電エネルギーを求めなさい。(電荷一定)

Q10-5 面積 $S[m^2]$ の同じ大きさの二枚の平行導体板が距離 $d[m]$ で配置されている。次の各場合について、両導体間に働く力を求めなさい。

- (1) 各導体板に $+Q[C]$ 、 $-Q[C]$ の電荷が与えられた時。(電荷一定)
- (2) 導体板間に一定電圧 $V[V]$ が印加された時。(電圧一定)

本日のまとめ

- 5問中、何問正解したか？
- 静電エネルギーを電荷と静電容量、および電圧と静電容量で表しなさい。
- 空気の絶縁破壊電界はどれくらいか。
- 誘電体内の分極を、電界と真空の誘電率および比誘電率で表しなさい。
- 二つの誘電体界面での電界の連続条件および電束密度の連続条件を説明しなさい。
- 強誘電体材料の特徴を書きなさい。
- 強誘電体材料は、どのような応用が考えられるか？